附圖

(一)證據 1 之圖示：

證據 1 為美國第 5939735 號專利「Semiconductor Light Emitting Device」

FIG. 1 (a)

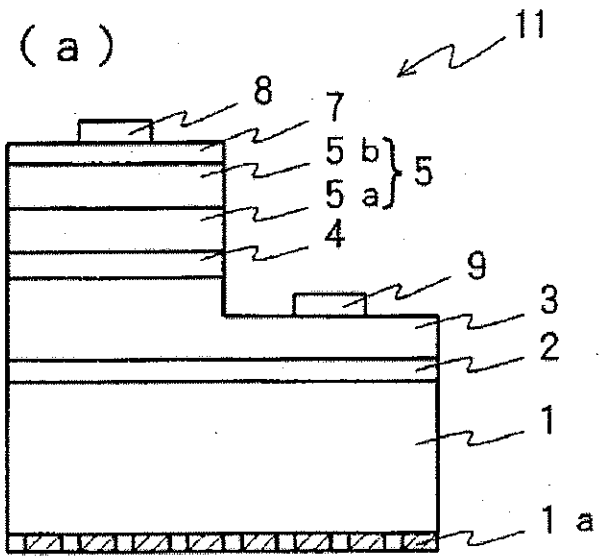
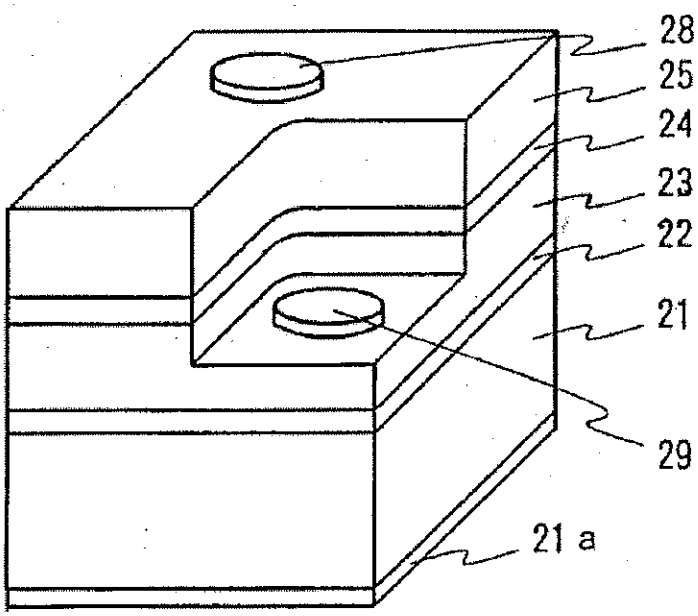
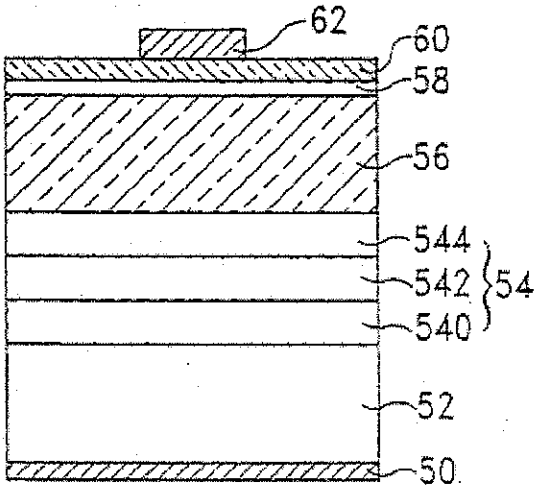


FIG. 4
PRIOR ART



(二)證據 2 之圖示：

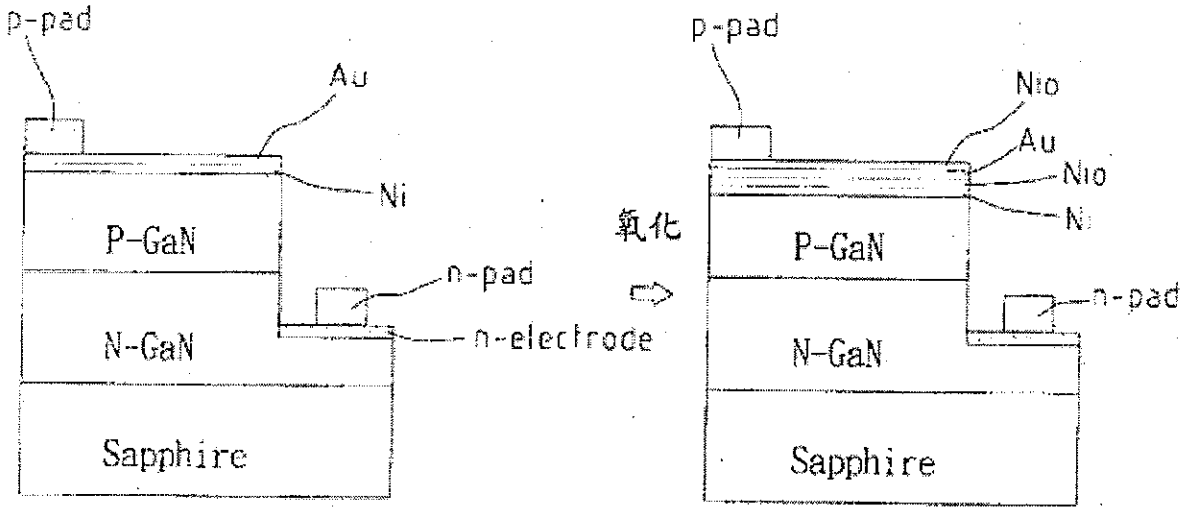
證據 2 為我國公告第 385553 號專利(申請案號 86104794)「高亮度發光二極體」



第 五 圖

(三)證據 3 之圖示：

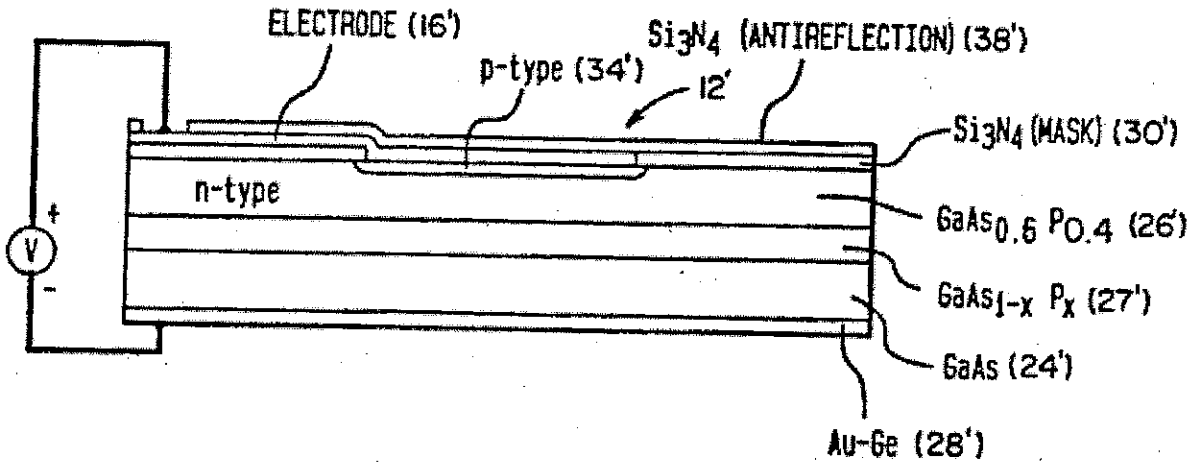
證據 3 為系爭專利公告本，其圖式第 1(A)圖、第 1(B)圖、第 1(C)圖為系爭專利所自承之習知技術，揭示習知之氮化鎵(GaN)系列藍光發光二極體(lightemitfing diode； LED)中，其晶粒所發射之藍光是經由一透光導電膜由 PGaN 面射出發光。



第一(C)圖

(四)證據 4 之圖示：

證據 4 為美國公告第 5077587 號專利「Light-emitting diode with anti-reflection layer optimization」



(五)證據 5 之圖示：

證據 5 為美國第 6015719 號專利「Transparent substrate light emitting diodes with directed light output」

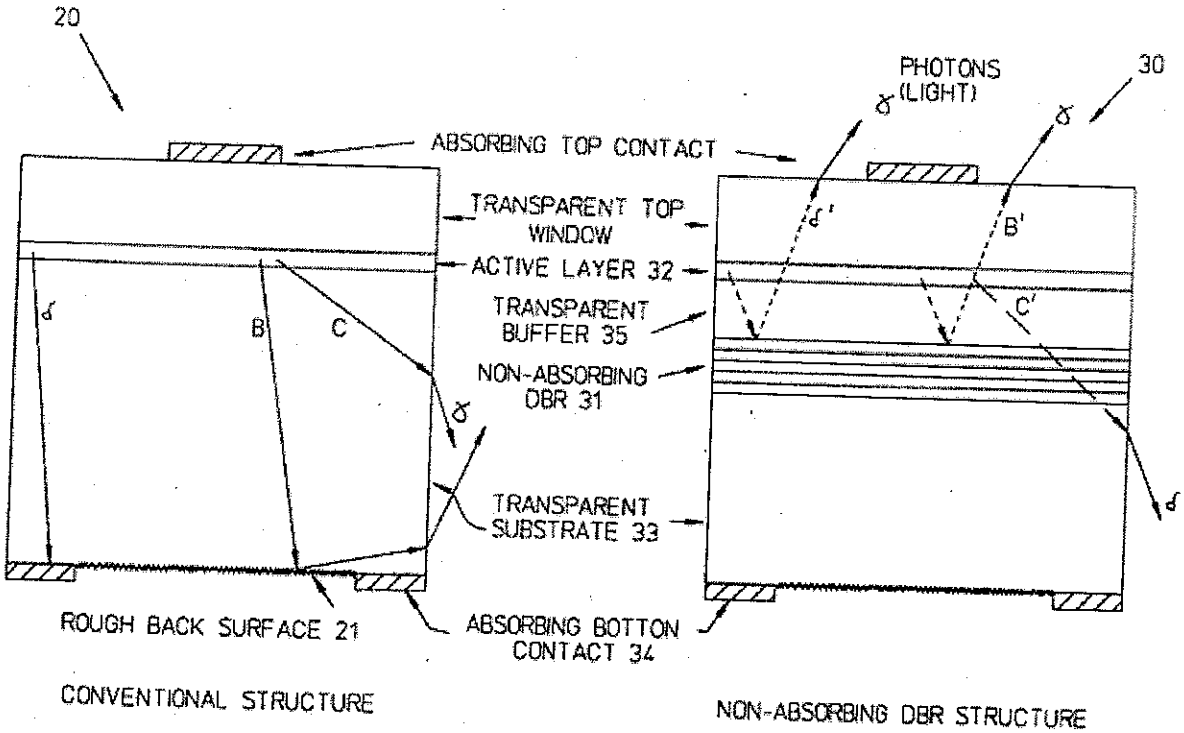


FIG. 3